

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN203MH(2SB861)	文件编号	临时
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/2

1 主要用途与主要特点

1.1 主要用途

用 W2XN203MH 封装的成品管主要用于功放输出。

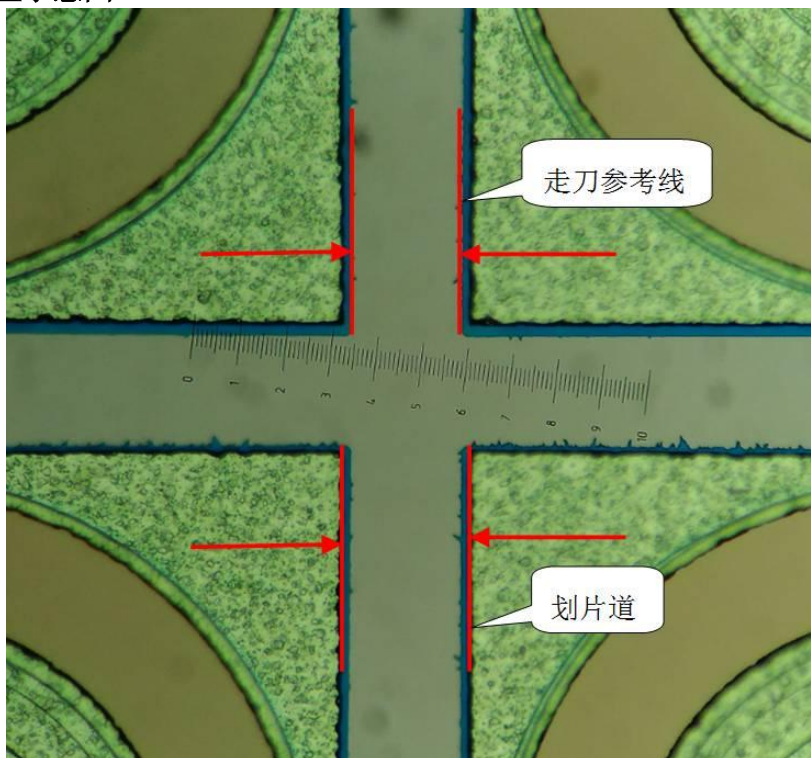
1.2 主要特点

- I_{CM} 大、二次击穿耐量高

2 芯片数据

芯片示意图 	芯片尺寸 (mm×mm)	1.5×1.5		
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20		
	划片道*尺寸 (μm)	50		
	键合区面积 (μm ²)	基区 (B)	280×630	
		发射区 (E)	290×870	
	钝化层	Si ₃ N ₄		
	正面电极	金属	铝	
		厚度(μm)	5.0±0.5	
	背面电极金属	银		
	硅片直径 (mm)	φ 125		
装片要求 (推荐)	铅锡烧结			
键合要求 (推荐)	铝丝: Φ150μm; E、B 区各一根			

* 划片道位置示意图:



备注: 划片道两侧铝条不断裂即判为合格。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN203MH(2SB861)	文件编号	临时
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	2/2

3 电特性（在推荐的封装形式、适当的封装条件下）

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CBO}	200	V	推荐封装形式: T0-220 推荐成品型号: 2SB861
集电极-发射极电压	V_{CEO}	160	V	
发射极-基极电压	V_{EBO}	5	V	
集电极电流	I_C	2	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	1.8	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}, I_E=0$			1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=50\text{mA}$	60		200	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$			2	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=150\text{mA}$ $f=10\text{MHZ}$	10			MHz

注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；

任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号

网址：<http://www.xs-elec.com>

电话：(0510) 86851182

传真：(0510) 86851532